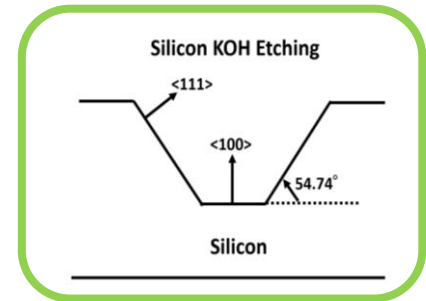
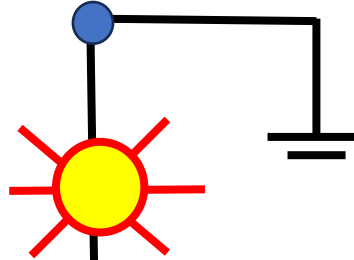


High Energy Ion 打ち込み工程の追加以外は、
従来の格安シングル接合型太陽電池と
製法は全く同一で生産できます。

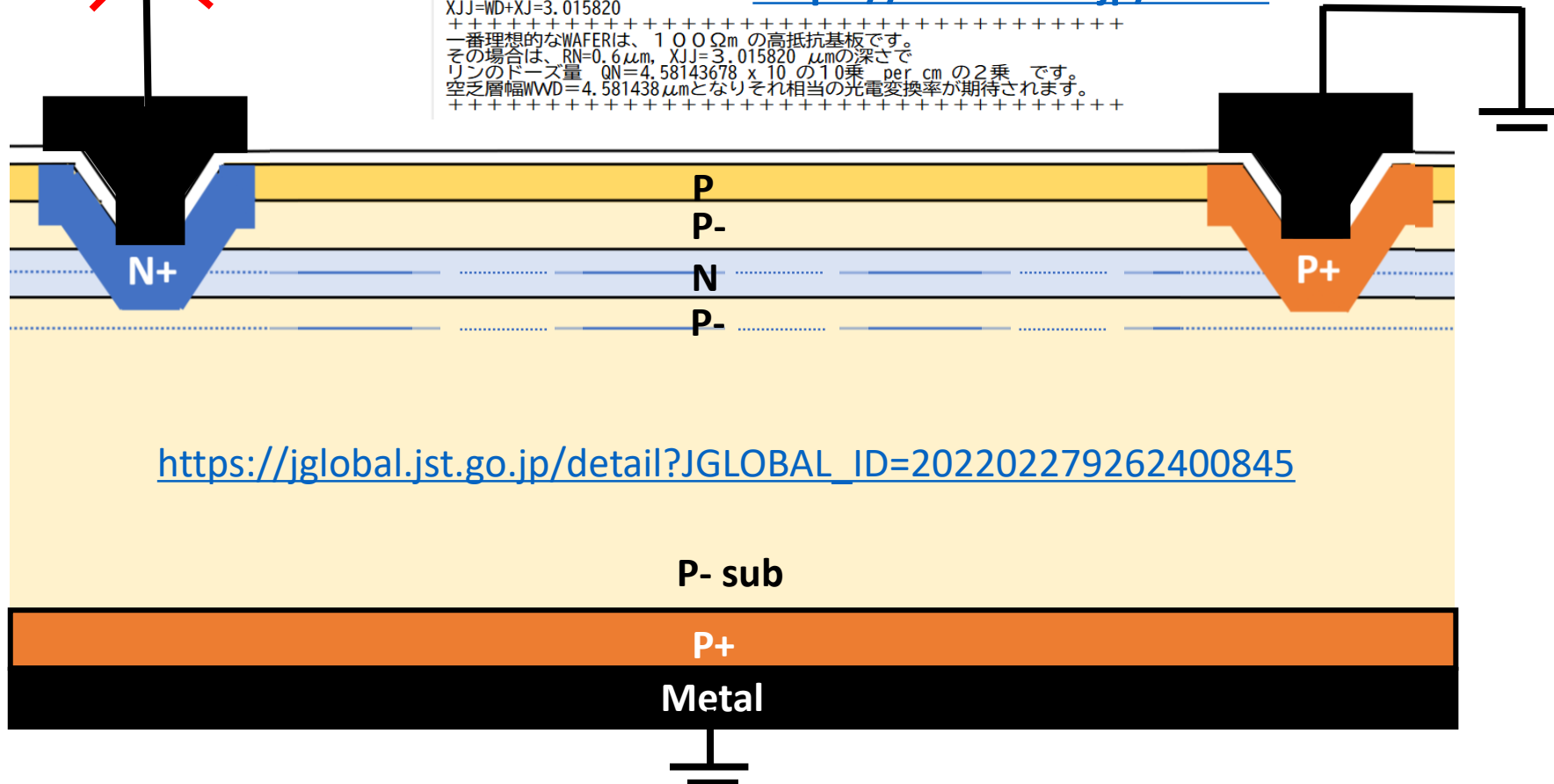


- Vout < 0



```
+++++
Vout=0.500000 RN=0.600000 としています。
+++++
DP=100.000000 の場合：
VBP=0.324852
VMAX=EG-VBP-Vout=0.285148
DNS=430.800000
A=DNS/DP=4.308000
QN=DNS*RN*RPI=458.143678
VV=DNS*RN*RN/Esi=0.239333
XJ=RN*log(sqrt(A))=0.725100
WWD=2*WD=2*Y*RN=4.581438
VM=-VV*W=0.285225
XJJ=WD+XJ=3.015820
+++++
一番理想的なWAFERは、100Ωmの高抵抗基板です。
その場合は、RN=0.6μm、XJJ=3.015820μmの深さで
リンのドーズ量 QN=4.58143678 x 10 の10乗 per cm の2乗 です。
空乏層幅WWD=4.581438μmとなりそれ相当の光電変換率が期待されます。
+++++
```

合同会社Locomtec/萩原aips研究所
<https://locomtec.jp/harl-1>



https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202202279262400845